








	<h2>RSD175N10TL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RSD175N10TL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 17.5A CPT3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RSD175N10TL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RSD175N10TL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 17.5A CPT3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	CPT3
Verlustleistung (max)	20W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 8.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RSD175N10TL ist neu im Original, Suche RSD175N10TL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RSD175N10TL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RSD175N10TL: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>RSD200N10FRATL</b> Original RSD200N10FRATL Original	 <b>RSD200N05</b> ROHM RSD200N05 ROHM	 <b>RSD160P05TL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 45V 16A CPT3	 <b>RSD200N05TL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 45V 20A CPT3
 <b>RSD175N10</b> TO-252 RSD175N10 TO-252	 <b>RSD200N10</b> ROHM RSD200N10 ROHM	 <b>RSD160P05 TL</b> ROHM RSD160P05 TL ROHM	 <b>RSD200N10TL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A CPT3

### heiße Teile

Mehr

⊕ 1812HA151KAT9A	↔ 6MBP100RTJ060	→ APT1608SURCK	D APT25GR120B	→ GRM188R71H103KA01J
⊖ LT1965EDD-2.5#PBF	⊕ RSD045P05	D RSD046P05	→ RSD046P05TL	→ RSD050N06
⊕ RSD050N06FRA	⊖ RSD050N06TL	⊕ RSD050N10	↔ RSD050N10FRA	→ RSD050N10TL
D RSD080N06	⊕ RSD080N06FRA	⊖ RSD080P05	⊕ RSD080P05FRA	→ RSD080P05TL
→ RSD100N10	↔ RSD100N10FRA	⊕ RSD100N10TL	⊖ RSD130P10	→ RSD130P10FMMTL
↔ RSD130P10TL	→ RSD131P10	D RSD131P10FRA	⊕ RSD140P06	⊖ RSD140P06FRA
⊕ RSD150N06	D RSD150N06TL	→ RSD160P05	↔ RSD160P05FRA	→ RSD160P05TL
⊖ RSD175N10	⊕ RSD175N10FRA	↔ RSD200N05	→ RSD200N10	→ RSD200N10FRATL
⊕ RSD200N10TL	⊖ RSD201N10	⊕ RSD201N10FRA	D RSD201N10TL	→ RSD220N06
↔ RSD220N06TL	⊕ RSD221N06	⊖ RSD221N06FRA	⊕ RSD221N06FRATL	→ TMV985B0035B

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited